
	<h2>SIR406DP-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIR406DP-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 25V 40A PPAK SO-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIR406DP-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 79937 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SIR406DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 40A PPAK SO-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	79937 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 25V 40A (Tc) 5W (Ta), 48W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	5W (Ta), 48W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	40A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.8 mOhm @ 15A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	50nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2083pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SIR406DP-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SIR406DP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIR406DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIR406DP-T1-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SIR406DP-T1-GE3-S</b> VISHAY SIR406DP-T1-GE3-S VISHAY</p>	 <p><b>SIR408DP-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 25V 50A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SIR406DP-T1-E3</b> VISHAY SIR406DP-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SIR408DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 25V 50A PPAK SO-8</p>
 <p><b>SIR404DP-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 60A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SIR404DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 60A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SIR410DP-T1</b> VISHAY SIR410DP-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SIR406DP</b> SI SIR406DP SI</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ SIR166DP	↔ SIR166DP-T1-E3	⇒ SIR166DP-T1-GE3	D SIR166DP-T1-GE3	⇒ SIR168DP
⊣ SIR168DP-T1-GE3	⊛ SIR168DP-T1-GE3	D SIR172ADP-T1-GE3	⇒ SIR172ADP-T1-GE3	⇒ SIR172DP
⊛ SIR172DP-T1-E3	⊣ SIR172DP-T1-GE3	⊛ SIR172DP-T1-GE3	↔ SIR330DP-T1-GE3	⇒ SIR330DP-T1-GE3
D SIR402DP-T1-GE3	⊛ SIR402DP-T1-GE3	⊣ SIR403EDP-T1-GE3	⊛ SIR403EDP-T1-GE3	⇒ SIR404DP
⇒ SiR404DP-T1-E3	↔ SIR404DP-T1-GE3	⊛ SIR404DP-T1-GE3	⊣ SIR406DP	⇒ SIR406DP-T1-E3
↔ SIR406DP-T1-GE3	⇒ SIR406DP-T1-GE3-S	D SIR408DP-T1-GE3	⊛ SIR408DP-T1-GE3	⊣ SiR410DP-T1-E3
⊛ SIR410DP-T1-GE3	D SIR410DP-T1-GE3	⇒ SiR412DP	↔ SiR412DP-T1-E3	⇒ SIR412DP-T1-GE3
⊣ SIR412DP-T1-GE3	⊛ SIR414DP	↔ SIR414DP-T1-GE3	⇒ SIR414DP-T1-GE3	⇒ SIR416DP
⊛ SiR416DP-T1-E3	⊣ SIR416DP-T1-GE3	⊛ SIR416DP-T1-GE3	D SiR418DP-T1-E3	⇒ SIR418DP-T1-GE3
↔ SIR418DP-T1-GE3	⊛ SIR422DP-T1-E3	⊣ SIR422DP-T1-GE3	⊛ SIR422DP-T1-GE3	⇒ SIR424DP-T1-GE3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited